BEST AVAILABLE COPY

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Buro



PCT

THE RESIDENCE OF THE PART OF THE PROPERTY OF THE PART OF THE P

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 20. Oktober 2005 (20.10.2005)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/098926 A1

- (51) Internationals Patentklassifikation7:
- H01L 21/331 (21) Internationales Aktemzeichen:
- PCT/EP2005/000500 (22) Internationales Anneldedatum:
- 19. Januar 2005 (19.01.2005) (25) Einreichungssprache:
- Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: (30) Anguben zur Priorität:

Doutsch

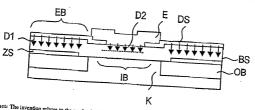
- 10 2004 013 478.2 18, Mirz 2004 (18.03.2004) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
- US): AUSTRIAMICROSYSTEMS AG [AT/AT]: Schloss Promstätten, A-8141 Unterpremstätten (AT). (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MEINHARDI, Ger ald [AT/AT]; Haydngasse 1, A-8010 Graz (AT). KRAFT,

- Jochen [DE/AT]; Paulahofsiedlung 42, A-8600 Oberaich
- (74) Annult: EPPING HERMANN & FISCHER PATEN-TANWALTSGFSELLSCHAFT MBH; Ridlerstr. 55, 80339 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (sowelt nicht anders angegeben, für jede verfüghare nationale Schuttrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, II., IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA.
- (84) Bestimmungsstauten (soweit nicht unders ungegehen, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW. GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF A BIPOLAR TRANSISTOR COMPRISING AN IMPROVED BASE TER-

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BIPOLARTRANSISTORS MIT VERBESSEKIURM BASIS-



(57) Abstruct: The invention relates to the production of an improved bipolar transistor provided with a low-obscuic base terminal, (gr) increases an incremon trainer to me production of an improved bipolar transistor provided with a low-obscute base terminal.

Generaling to suit during the distribution of the production of an improved bipolar transistor provided with a low-obscute base terminal. Generalized the production mask. In a subsection controlled thereties the mask and high doping is to be carried via an experimental controlled thereties the mask and high doping is to be carried via an experimental controlled thereties the mask and the production of the production of the mask and the production of the m Concluding to said methods in the control of the production of an improved bipolar transistor provided with a low-obstite tonsistent provided with a low-obstite transistent provided with a low-obstite transistent production and high doping is to be carried to an objectic layer which act is a subjection to adopting to the carried to an objectic layer which act is a subject to a deposit store. As a result, a low-obstite region is produced which defines the extrinsic base in a practice of the control of the contro

(2) 2005. Billionenfassung: Zur Herstellung eines verbetserten Bipolartunsistors mit niederohmigen Bastsanschluss wird vorgeschla-g, gber dem Halbleiterpubstrat eine dielektrische Schicht abzunebalden und ihm sich son perioden dielektrischen Kolatroliterten Internischen Schrit wird der Douerstoff unschliessend aus der als Douerstoffdeport die-dreften dielektrischen Schalch in des Halbleitersabstrat eindiffundiert. Dabei entsteht ein niederohmiger Bereich, mit dem die ein-ziele Bass schonend definiert werden kann. Principular Basis schonend definiert werden kann.